

加工

(成膜装置群)

デュアルイオンビームスパッタ装置

ハシノテック社製 10W-IBS

仕様

イオン源	熱陰極型イオン源 (φ 4インチ径) ビーム電圧: 50~1000V ビーム電流: 最大200mA
到達真空度	8×10^{-5} Pa以下
基板温度	室温~700°C
基板ホルダ	回転機能付き, 4インチまで対応可能
保有ターゲット	Si, SiO ₂ , Ti, Al, Cr等
堆積速度	約20 nm/min (SiO ₂)
膜厚の均一性	約5%以下 (4インチ内)



ビーム引き出し電極



ターゲット



基板ステージ



薄膜形成(微細加工)

イオン源を2基搭載したデュアルイオンビームスパッタ装置です。通常のスパッタによる薄膜形成以外に、薄膜形成の前処理の基板クリーニングや薄膜形成中のイオンの同時照射が可能です。更に、イオンビームエッチング装置として用いることもできます。

- ・高純度な薄膜形成や膜の組成制御性に優れており、高品質薄膜の低温形成が可能
- ・多層薄膜、光学薄膜、磁性薄膜等の高機能薄膜形成にも有利
- ・ビーム同時照射効果により、薄膜の膜質向上(結晶性、密着性、応力制御性、硬質化等)が可能。

「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業」

微細加工プラットフォーム ・ 香川大学



お問い合わせ先

香川大学 産学連携・知的財産センター
ナノテクノロジー支援室

TEL/FAX: 087-887-1873

E-mail: nanoplatform-c@kagawa-u.ac.jp